

บทที่ ๓

วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้กล่าวถึงอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย ตลอดรวมถึงขั้นตอนและวิธีการทดลอง ดังต่อไปนี้
การเตรียมพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เพื่อส่องไฟ การเตรียมพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพและสมบัติทางแสงของพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจนได้แก่ ค่าดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดับสูญ และแบบพลังงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

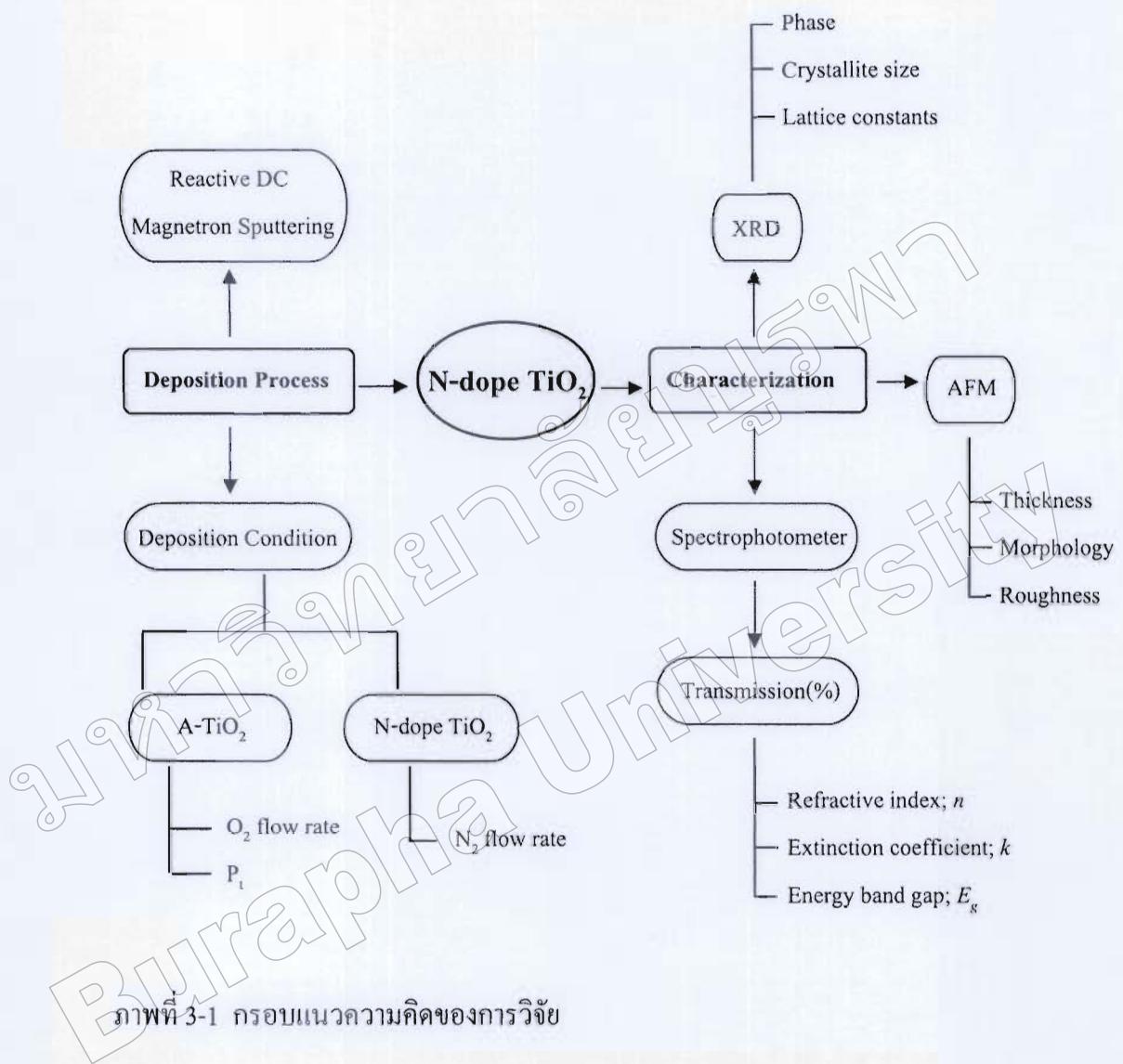
กรอบแนวคิดของงานวิจัย

ผู้วิจัยแบ่งการดำเนินงานของวิทยานิพนธ์เป็น 4 ส่วนคือ (1) การเตรียมพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เพื่อส่องไฟ (2) การเตรียมพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน (3) การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์และพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน และ (4) การศึกษาสมบัติทางแสงของพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน สรุปได้ดังนี้

การเตรียมพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน เริ่มจากศึกษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลือบ ตัวแปรและขั้นตอนการเคลือบ ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้ใช้การเคลือบด้วยวิธีรังสรรค์ฟลักซ์แมกนิตรอนสปีดเตอริง จากนั้นจึงทดลองเคลือบพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เพื่อส่องไฟ โดยศึกษาผลของอัตราไอลแก๊สในไตรเจน ต่อโครงสร้างและสมบัติทางแสงของพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์ และทดลองเคลือบพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน โดยศึกษาผลของอัตราไอลแก๊สในไตรเจน ต่อโครงสร้างและสมบัติทางแสงของพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน

การศึกษาลักษณะเฉพาะของพิล์มนไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจนที่เคลือบได้ด้วยเทคนิค XRD เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิช (Lattice Constants) และใช้เทคนิค AFM เพื่อศึกษาความหนา และลักษณะพื้นผิว

สำหรับสมบัติทางแสงของพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน ศึกษาโดยนำพิล์มนบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจนไปวัดค่าการส่งผ่านแสงด้วยเครื่องสเปกตรโฟโนเมเตอร์ จากนั้นนำค่าการส่งผ่านแสงที่ได้ไปคำนวณหาค่าดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดับสูญ และแบบพลังงาน



เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

1. การเตรียมฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์และฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน

1.1 เครื่องเคลือบสูญญากาศระบบบริแอคเตอร์ดีซีเมกนิตรอนสปัตเตอริง ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ เครื่องเคลือบที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสูญญากาศและฟิล์มบาง ภาควิชาพิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาพที่ 3-2)

1.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

1.2.1 เป้าสารเคลือบเป็นเป้าไทเทนเนียม มีความบริสุทธิ์ 99.97 %

1.2.2 วัสดุรองรับ (Substrate) มี 2 ชนิดคือ

- กระดาษไอล์ด์ใช้เพื่อศึกษาสมบัติทางแสง

- แผ่นซิลิโคนใช้ในการศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดเล็ก ค่าคงที่เดทด้วยความหนา และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบาง

1.2.3 แก๊ส (Gas) ประกอบด้วยแก๊ส 3 ชนิดคือ

- แก๊สรากอน (99.999%) เป็นแก๊สสปัตเตอร์ (Sputtered Gas)

- แก๊สออกซิเจน (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา (Reactive Gas)

- แก๊สไนโตรเจน (99.995%) เป็นแก๊สเจือ (Doped Gas)

2. การหาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบาง

2.1 X-Ray Diffractometer สำหรับศึกษาโครงสร้างผลึก งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง X-ray Diffractometer Bruker รุ่น D8 โดยใช้ Cu- k_α ($\lambda = 1.54056 \text{ \AA}$) ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชานนาทนบุรี (ภาพที่ 3-3)

2.2 Atomic Force Microscope สำหรับศึกษาความหนา และลักษณะพื้นผิว งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง Atomic Force Microscope รุ่น Nanoscope IV (Veeco Instruments Inc.) ของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาพที่ 3-4)

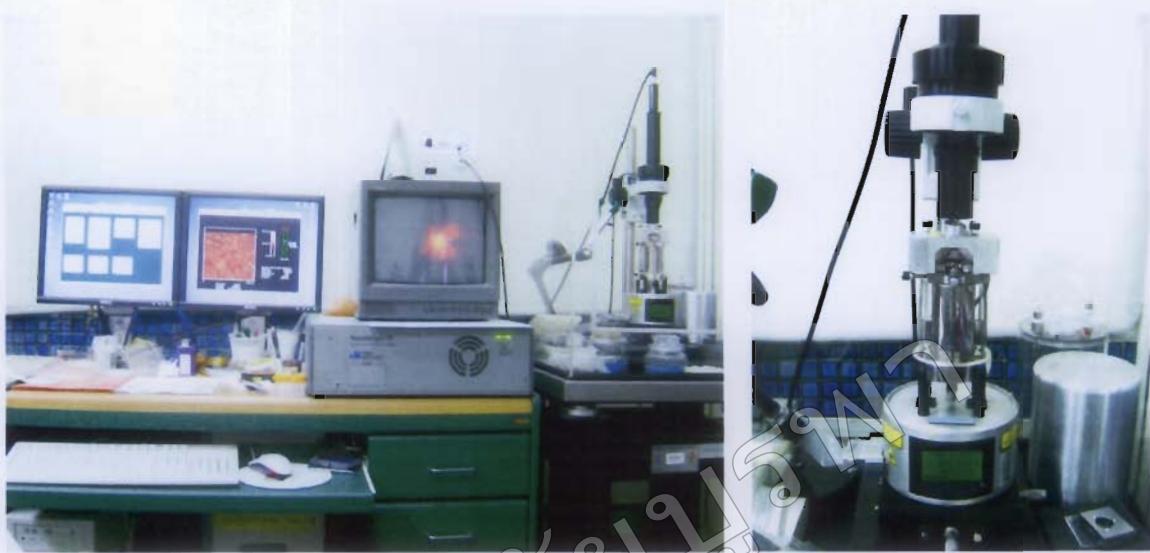
2.3 Spectrophotometer สำหรับวัดค่าการส่งผ่านแสงในช่วง 200-2500 nm งานวิจัยนี้จะใช้เครื่อง Spectrophotometer รุ่น UV-VIS-NIR 3600 (Shimadzu Co., Ltd) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



ภาพที่ 3-2 เครื่องเกลือบสูญญากาศระบบบีเอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปีตเตอริงที่ใช้ในงานวิจัย



ภาพที่ 3-3 เครื่อง X-Ray Diffractrometer



(a)

(b)

ภาพที่ 3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope



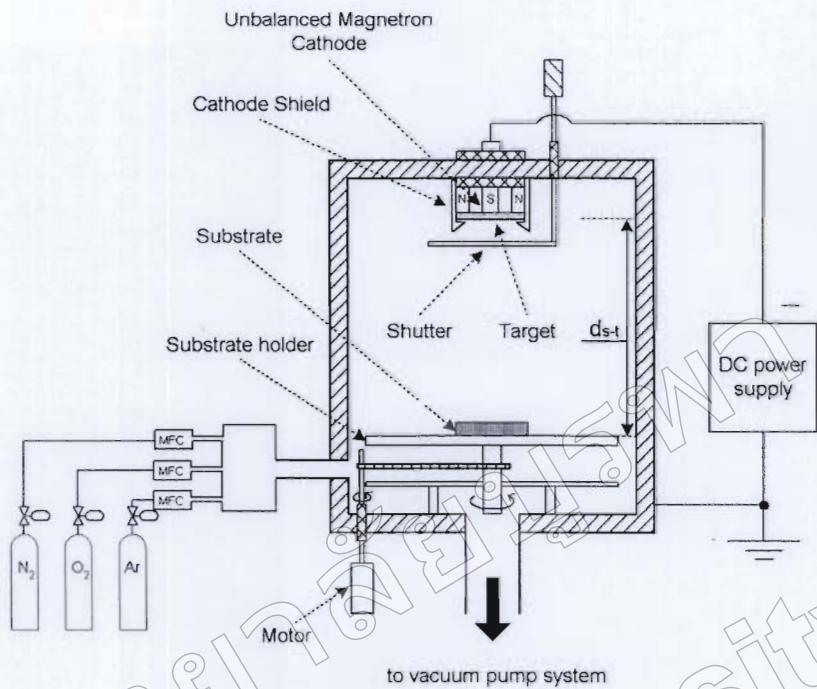
ภาพที่ 3-5 เครื่อง Spectrophotometer

เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบบริแอคตีฟดีซีสปัตเตอริง

ฟิล์มบางไทเทเนียม ได้ออกใช้ดีเจ้อใน โทรเจนในงานวิทยานิพนธ์นี้ เตรียมจากเครื่องเคลือบในสัญญาการระบบดีซีอันบาลานซ์แมกนีตอรอนสปัตเตอริง (ภาพที่ 3-6) ด้วยเทคนิค ริแอคตีฟสปัตเตอริง ซึ่งเป็นกระบวนการภายใต้สภาพสุญญากาศ ดังนั้นเพื่อให้ฟิล์มบางที่ได้มีคุณภาพและสมบัติตามที่ต้องการ จะต้องลดความดันภายในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในระดับ 10^{-5} mbar ส่วนประกอบของเครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของระบบสุญญากาศ (Vacuum System) และ ส่วนของระบบเคลือบ (Coating System) รายละเอียดดังนี้

- ส่วนระบบสุญญากาศ ประกอบด้วย ห้องเคลือบทรงกระบอกทำจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 310.0 mm สูง 370.0 mm ระบบเก็บร่องสูบสุญญากาศประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร่ ไอแบบบรรยายความร้อนด้วยน้ำและมีเครื่องสูบกลโตรารีเป็นเครื่องสูบท้าย การวัดความดันภายในภาชนะสุญญากาศใช้มาตรวัดความดันของ Balzers รุ่น TPG300 โดยใช้หัววัดแบบพิรานี รุ่น TPR010 และหัววัดแบบเพนนิ่งรุ่น IKR050

- ส่วนของระบบเคลือบ เป็นส่วนเตรียมฟิล์มบาง ไทเทเนียม ได้ออกใช้ดีเจ้อใน โทรเจน ประกอบด้วย แมกนีตอรอนค่าโทด 2 หัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 54.0 mm บรรยายความร้อนด้วยน้ำ ติดตั้งเป้าไทเทเนียม (99.99%) ที่ค่าโทด หัวอุ่นภาคข้างไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ใช้แก๊สอาร์กอน ความบริสุทธิ์สูง (99.999%) เป็นแก๊สสปัตเตอร์ ใช้แก๊สออกซิเจนความบริสุทธิ์สูง (99.995%) และแก๊สใน โทรเจนความบริสุทธิ์สูง (99.995%) เป็นแก๊สไวนิลิริยา สำหรับการจ่ายแก๊สอาร์กอน แก๊สออกซิเจนและแก๊สใน โทรเจนในกระบวนการเคลือบจะควบคุมด้วย Mass Flow Controller ของ MKS type247D



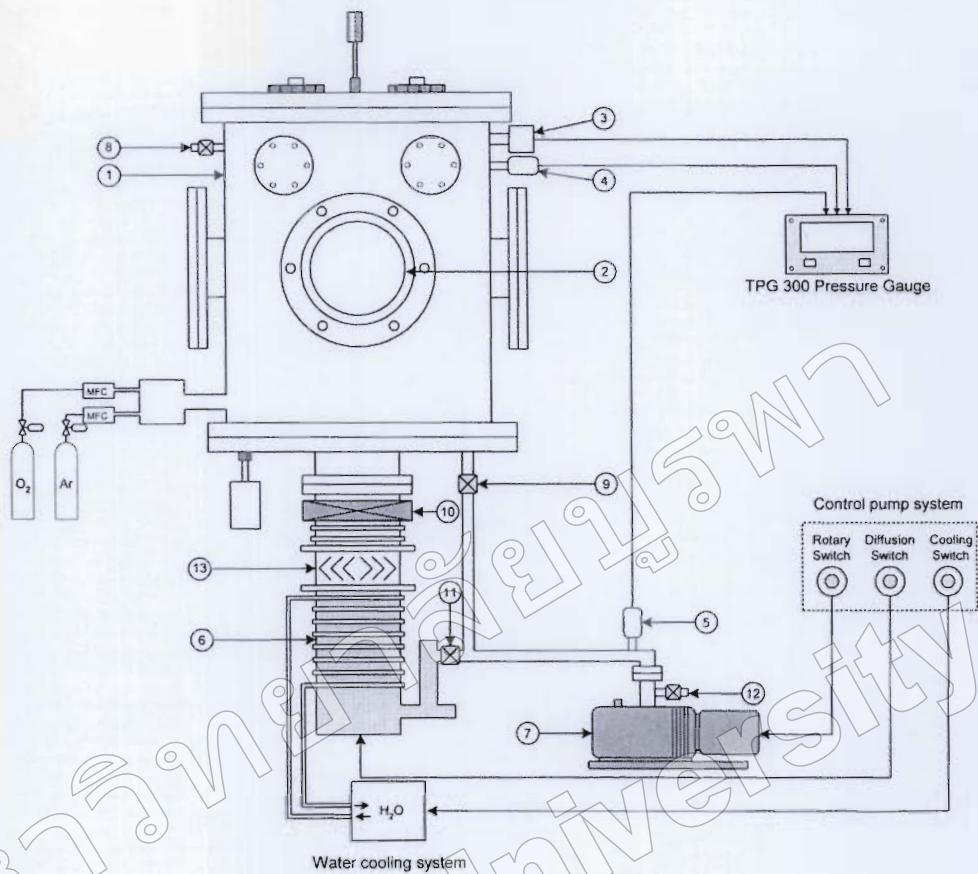
ภาพที่ 3-6 ไคโอบาร์นของเครื่องเคลือบ

การสร้างสภาวะสุญญากาศ

ก่อนทำการเคลือบฟลั่มด้วยวิธีสปูตเตอริง ต้องทำการดันในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในสภาวะสุญญากาศที่ระดับสุญญากาศสูง (High Vacuum) ความดันประมาณ 10^{-3} - 10^{-5} mbar เพื่อลดการปนเปื้อนของฟลั่มที่เคลือบ ได้นำเสนอของการคงค้างของแก๊สในภาชนะสุญญากาศ (Residual Gas) การสร้างสภาวะสุญญากาศจะใช้ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร่ไอ (Diffusion Pump) หนุนหลังด้วยเครื่องสูบกลโตรารี (Rotary Pump) ที่ต่อเข้ากับภาชนะสุญญากาศ ด้วยท่อและมีวาล์วควบคุมการปิด-เปิด (ภาพที่ 3-7) โดยในตอนดันจะใช้เครื่องสูบกลโตรารีเพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากษาจากความดันบรรยากาศเป็นความดันต่ำประมาณ 10^{-2} mbar ต่อมาจะใช้เครื่องสูบแบบแพร่ไอ เพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากษาจาก 10^{-2} mbar ให้ลดลงอยู่ในช่วงความดัน 10^{-5} mbar

สำหรับขั้นตอนการสร้างภาวะสุญญาการมีดังนี้

1. ตรวจเช็ค瓦ล์ว haya (หมายเลข 9) วาล์วท้าย (หมายเลข 11) และวาล์วสุญญาการสูง (หมายเลข 10) ให้อยู่ในสภาพปิดทั้งหมด
2. เปิดสวิทซ์หลัก เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบต่าง ๆ ของเครื่อง เช่น ระบบวัดความดัน และระบบควบคุมการทำงานของระบบเครื่องสูบน้ำสุญญาการ เป็นต้น หลังจากนั้นเปิดสวิทซ์ Rotary เพื่อให้เครื่องสูบกลไตรารี (หมายเลข 7) ทำงาน
3. เริ่มน้ำจากเครื่องสูบแบบแพร์โไอ โดยใช้เครื่องสูบกลไตรารี โดยเปิดวาล์วท้าย เพื่อให้เครื่องสูบกลไตรารีสูบอากาศออกจากเครื่องสูบแบบแพร์โไอ (หมายเลข 6) จนความดันในเครื่องสูบแบบแพร์โไอ เมื่ออ่านจากพิรานีเกจ (หมายเลข 4) มีค่าอยู่ที่ 10^{-2} mbar ซึ่งเป็นความดันที่เครื่องสูบแบบแพร์โไอ สามารถทำงานได้ พร้อมทั้งเปิดสวิทซ์ Diffusion เพื่อให้ตัวทำความร้อนของเครื่องสูบแบบแพร์โไอทำงานเป็นการเริ่มน้ำมัน ใช้ประมาณ 20 นาที
4. ในระหว่างการต้มน้ำมันน้ำสตอร์องรับที่ต้องการเคลือบวงในภาชนะสุญญาการ โดยก่อนวางวัสดุรองรับต้องตรวจความดันใน ภาชนะสุญญาการยังคงอยู่ในสภาพเป็นสุญญาการ หรือไม่ ถ้ายังเป็นสุญญาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้อากาศเข้าสู่ภาชนะสุญญาการ จนความดันในภาชนะสุญญาการเท่ากับความดันบรรยายการ หลังจากนั้นทำการเปิดฝาครอบภาชนะสุญญาการออก นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบไปปะปิดฝาครอบและปิดวาล์วปล่อยไห้สูญญากาศ จนความดันในภาชนะสุญญาการมีค่าประมาณ 10^{-2} mbar เมื่ออ่านความดันจากมาตรวัดความดันแบบช่วงกว้าง (หมายเลข 3)
5. สร้างสภาพสุญญาการขั้นต้นในภาชนะสุญญาการโดยใช้เครื่องสูบกลไตรารี โดยการปิดวาล์วท้าย แล้วเปิดวาล์ว haya เพื่อให้เครื่องสูบกลไตรารีสูบอากาศออกจากภาชนะสุญญาการ จนความดันในภาชนะสุญญาการ มีค่าประมาณ 10^{-5} - 10^{-6} mbar เมื่ออ่านความดันจากมาตรวัดความดันแบบช่วงกว้าง (หมายเลข 3)
6. เมื่อต้มน้ำมันจนครบ 20 นาที ทำการสร้างสภาพสุญญาการสูง ในภาชนะสุญญาการ ด้วยเครื่องสูบแบบแพร์โไอ โดยปิดวาล์ว haya แล้วเปิดวาล์วท้าย หลังจากนั้นเปิดวาล์วสุญญาการสูง เพื่อให้เครื่องสูบแบบแพร์โไอสูบอากาศออกจากภาชนะสุญญาการเพื่อทำความสะอาดด้านในภาชนะสุญญาการให้อยู่ในระดับสภาพสุญญาการสูง หรืออยู่ในช่วง 10^{-5} - 10^{-6} mbar
7. จับเวลาและรอจนความดันในภาชนะสุญญาการมีค่าประมาณ 5×10^{-5} mbar ซึ่งกำหนดให้เป็นค่าความดันพื้น (P_0) ก่อนเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์ม ไทเกเนียมเจือในโตรเจน



ภาพที่ 3-7 ไคโอะเกะมรรบบเครื่องสูบน้ำยาแก๊ส ของระบบเคลื่อนสปีดเตอริ่ง

- | | |
|---|--|
| 1. ภาชนะสูบน้ำยาแก๊ส (Vacuum Chamber) | 2. หน้าต่าง (Window) |
| 3. มาตรวัดความดันเพนนิ่ง (Penning Gauge) | 4. มาตรวัดความดันพิรานี (Pirani Gauge) |
| 5. มาตรวัดความดันแบบพิรานี (Pirani Gauge) | 6. เครื่องสูบแบบแพร์โซ (Diffusion Pump) |
| 7. เครื่องสูบกลโตรตารี (Rotary Pump) | 8. วาล์วปล่อย (Vent Valve) |
| 9. วาล์วหายา (Roughing Valve) | 10. วาล์วสูบน้ำยาแก๊สสูง (High Vacuum Valve) |
| 11. วาล์วท้าย (Backing Valve) | 12. วาล์วปล่อย (Vent Valve) |
| 13. แบนฟ์เฟิล (Baffle) | |

การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์ม

ทั้งนี้ก่อนนำวัสดุรองรับมาเคลือบฟิล์มต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อขัดสิ่งสกปรกได้แก่ คราบผุน ไขมันสารอินทรีย์ต่าง ๆ ก่อน ซึ่งจะทำให้ได้วัสดุรองรับที่ได้มีความสะอาดทำให้ฟิล์มที่เคลือบยึดติดแน่นลงบนผิวน้ำของวัสดุรองรับ สำหรับการทำความสะอาดวัสดุรองรับเริ่มจากนำวัสดุรองรับไปล้างด้วยไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) โดยใช้อัลตราโซนิกส์เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำไปล้างด้วยอะซิโตน โดยใช้อัลตราโซนิกส์เป็นเวลา 5 นาที และนำไปล้างต่อด้วยไอโซโพรพานอล (Isopropanol) โดยใช้อัลตราโซนิกส์อีก 5 นาที นำวัสดุรองรับขึ้นด้วยคีมคีบ เป่าด้วยลมร้อนให้แห้ง จากนั้นนำวัสดุรองรับใส่เข้าในภาชนะสุญญากาศเพื่อรอการเคลือบดังแสดงในภาพที่ 3-8



ภาพที่ 3-8 การล้างวัสดุรองรับ

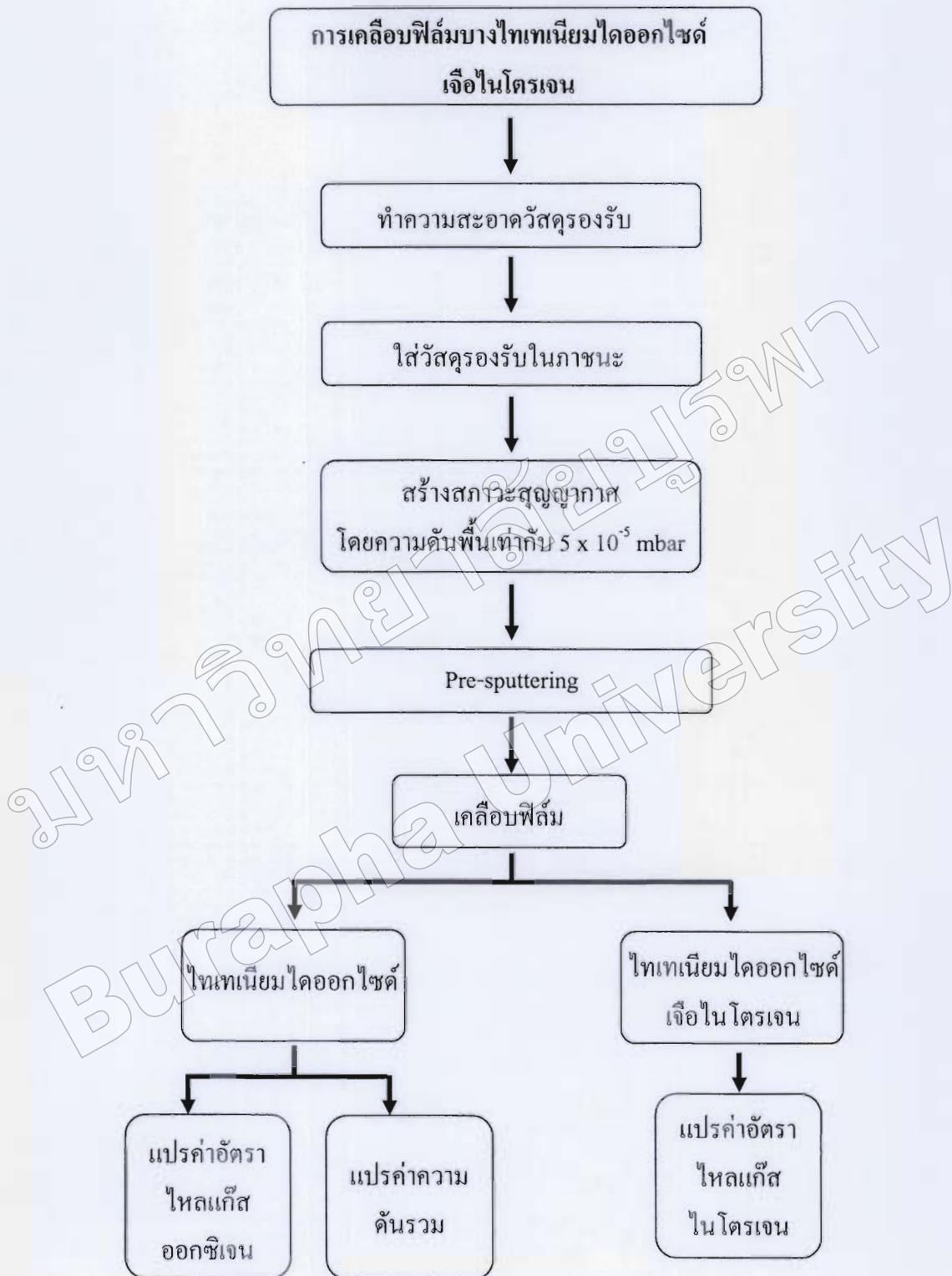
การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฟฟ้าในโตรเจน

การเคลือบฟิล์มบางในภาชนะสูญญากาศด้วยวิธีร็อกต์ฟิดซีแมกนีตอรอนสปีดเตอริง มีรายละเอียดพื้นฐานได้ดังนี้ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงถูกติดตั้งเข้ากับระบบเคลือบโดยต่อ สักย์ไฟฟ้าลบเข้ากับขั้วคาโทดและต่อสักย์ไฟฟ้าบวก (Ground) กับภาชนะสูญญากาศ เป้าไทเทเนียม จะถูกติดตั้งกับขั้วคาโทด โดยด้านบนของคาโทดจะต่อ กับระบบไอลเวียนนำเย็นเพื่อใช้ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณคาโทดจากการสปีดเตอร์ของไอลเวียนอาร์กอนที่บริเวณผิวน้ำเป้าสารเคลือบ ส่วนสครูองรับถูกวางบนแผ่นรองรับที่ติดตั้งบนแท่นวางที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ โดยชัตเตอร์ (Shutter) ใช้สำหรับกันระหว่างวัสดุองรับกับปีกสารเคลือบ เพื่อป้องกันการเคลือบผิววัสดุองรับ ในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดหน้าเป้า (Pre Sputtering) และอุปกรณ์ Control Unit ที่เชื่อมต่อกับ Mass Flow Controller (MFC) ใช้มัคกินกิบการทำงานของเครื่องควบคุมการปล่อยแก๊สอย่างละเอียด เพื่อควบคุมอัตราการไอลของแก๊สอาร์กอน แก๊สออกซิเจนและแก๊สในโตรเจนที่เข้าสู่ภาชนะสูญญากาศ โดยค่าอัตราการไอลของแก๊สจะมีหน่วยเป็น Standard Cubic Centimeter per Minute at STP (scm)

ขั้นตอนในการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฟฟ้าในโตรเจน มีรายละเอียดดังนี้

1. นำวัสดุองรับที่ต้องการเคลือบวางไว้บนแท่นวางวัสดุองรับ ปิดชัตเตอร์หน้าเป้าไทเทเนียม แล้วปิดฝาภาชนะสูญญากาศ
2. ลดความดันภายในภาชนะสูญญากาศเหลือ 5×10^{-5} mbar กำหนดเป็นค่าความดันพื้น (P_b) ของระบบก่อนทำการเคลือบฟิล์ม บันทึกค่าความดัน P_b ที่อ่านได้
3. ห้ามความสะอาดหน้าเป้าสารเคลือบด้วยกระบวนการ Pre-Sputtering เป็นเวลา 3 นาที
4. ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มโดยเริ่มจากการปล่อยแก๊สอาร์กอน แก๊สออกซิเจนและแก๊สในโตรเจนเข้าสู่ภาชนะสูญญากาศ ตามค่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการทดลอง
5. จ่ายสักย์ไฟฟ้าลบให้แก่คาโทด จนเกิด โกลด์ซิชาร์จ (ชัตเตอร์ยังคงปิดอยู่) เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้คาโทดและกระแสคาโทดที่วัด ได้ไม่เปลี่ยนแปลง จะเริ่มการเคลือบฟิล์มบางโดยปิดชัตเตอร์ที่ปิดหน้าเป้าออก เพื่อเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มลงบนวัสดุองรับ พร้อมทั้งบันทึกผลค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (H) ค่ากระแสไฟฟ้า (I) และความดันรวม (P) ที่เกิดขึ้นขณะเริ่มเคลือบฟิล์ม และทำการเคลือบฟิล์ม ตามเวลา (t) ที่กำหนด

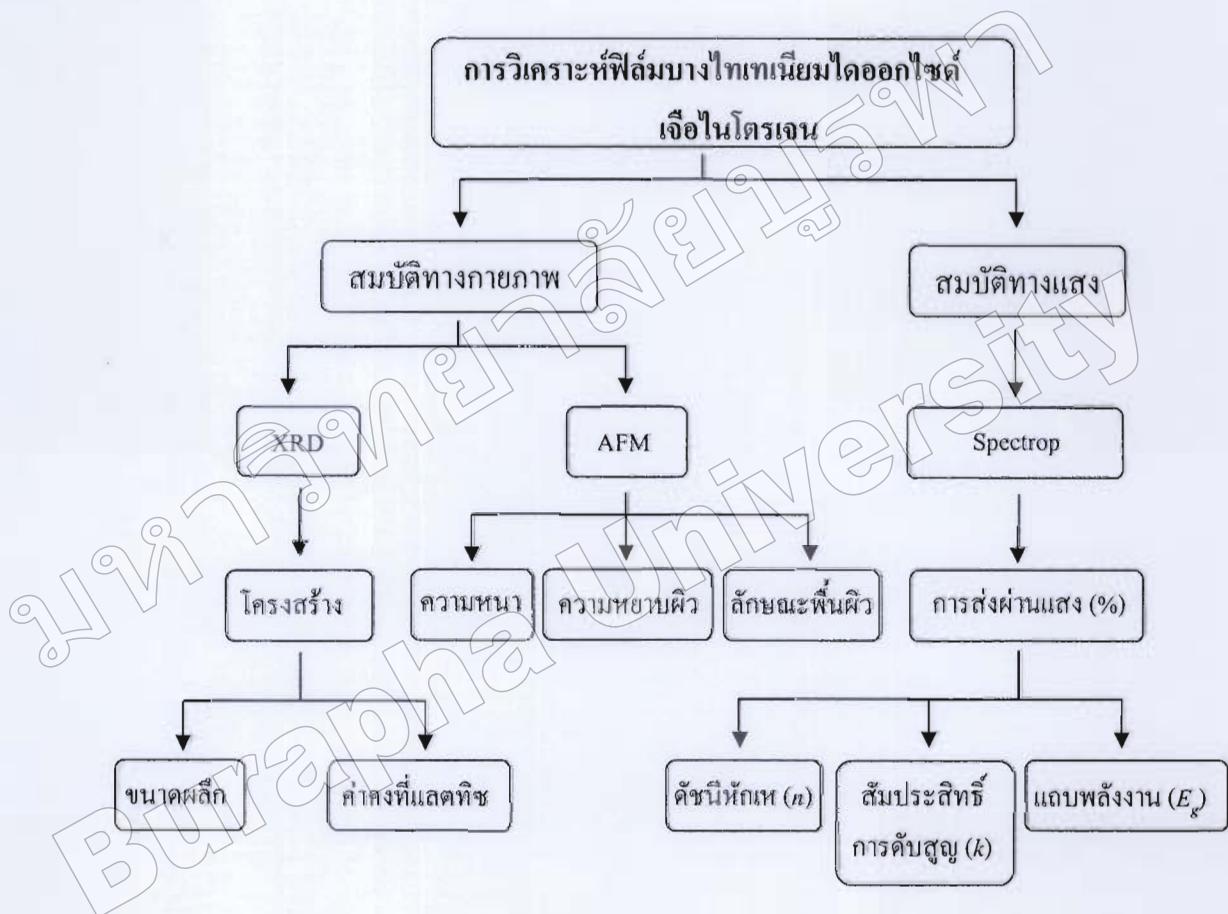
6. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบฟิล์ม ปิดแหล่งจ่ายไฟ ปิดแก๊สอาร์กอน ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สในโตรเจน และปล่อยอากาศเข้าไปในภาชนะสูญญากาศ เพื่อนำวัสดุองรับออก



ภาพที่ 3-9 การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

การวิเคราะห์ฟิล์มน้ำงาไทยเนี่ยมโดยออกไซด์เจือในไตรเรน

การวิเคราะห์ฟิล์มน้ำงาไทยเนี่ยมโดยออกไซด์เจือในไตรเรนในงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) โครงสร้างผลึกและลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มน้ำงาไทยเนี่ยมโดยออกไซด์เจือในไตรเรน และ (2) สมบัติทางแสงของฟิล์มน้ำงาไทยเนี่ยมโดยออกไซด์เจือในไตรเรน



ภาพที่ 3-10 การวิเคราะห์ฟิล์มน้ำงาไทยเนี่ยมโดยออกไซด์เจือในไตรเรน

1. โครงสร้างผลึกและลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ เจือ ใน โครงการขั้นตอนนี้ เป็นการนำฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ เจือ ใน โครงการที่ได้มีมาศึกษา โครงสร้างผลึกขนาดผลึก ค่าคงที่แลดทิช ลักษณะพื้นผิวและความหนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ เจือ ใน โครงการ โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านการเคลือบแล้ว มาทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray Diffractrometer เพื่อหาโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ เจือ ใน โครงการที่เกิดขึ้น โดยจะใช้ $Cu-k\alpha$ เป็นแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ใน Mode Low Angle กำหนดมุมวัดอยู่ในช่วง $20^\circ - 65^\circ$ สเปกตรัมที่วัดได้นำไปเปรียบเทียบกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ มาตรฐานอ้างอิงของแฟ้ม JCPDS

1.2 การหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ เจือ ใน โครงการ สำหรับการหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ เจือ ใน โครงการสามารถหาได้จากรูปแบบ โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractrometer โดยใช้ Seherfer Equation ในการคำนวณหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ เจือ ใน โครงการที่ได้หลัง การเคลือบ

1.3 การหาค่าคงที่แลดทิชของฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ เจือ ใน โครงการ สำหรับ การค่าคงที่แลดทิชของฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ เจือ ใน โครงการสามารถหาได้จากรูปแบบ โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractrometer โดยใช้สมการการหาระยะห่างระหว่างรูร่องนาโนผลึกของฟิล์มที่มีโครงสร้างแบบเตตระ โภนอล ในการคำนวณหาค่าคงที่แลดทิชของฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ เจือ ใน โครงการที่ได้หลังการเคลือบ

1.4 การหาความหนาของฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ เจือ ใน โครงการ โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้ว ไปวัดความหนาด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยใช้เข็มขนาดเล็กทำจากซิลิคอนในโทรศัพท์เคลื่อนที่กรุดบนผิวฟิล์มบางเพื่อตรวจวัด ความหนา

1.5 การศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทนี่ยม ได้ออกใช้ค์ เจือ ใน โครงการ โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้ว ไปวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วย เครื่อง Atomic Force Microscope โดยมีความละเอียดในระดับนาโน และใช้พื้นที่ในการวิเคราะห์เท่ากับ $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ พร้อมวัดค่าความหยาบผิว

2. สมบัติทางแสงของฟิล์มนบางไทเทเนียม ได้ออกไซด์เจือในโตรเจน ขั้นนี้คำนวณหาค่าคงที่ทางแสงของฟิล์มนบางไทเทเนียม ได้ออกไซด์เจือในโตรเจนด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ วัดค่าการส่งผ่านแสงบนกระจกสไลด์ที่เป็นวัสดุรองรับ แล้วนำมาคำนวณหา ดังนีหักเหสัมประสิทธิ์การดับสัญญาณและแบบพัฒงาน

2.1 การหาดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสัญญาณสเปกตรัมการส่งผ่านแสง ดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสัญญาณของฟิล์มนบางหางาจวิช Envelope โดยใช้ข้อมูลจากสเปกตรัมการส่งผ่านแสงในการคำนวณซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

2.1.1 การหาดัชนีหักเห (n)

2.1.1.1 นำฟิล์มนบางที่เคลือบบนกระจกสไลด์ไปทำการวัดเบอร์เร็นต์การส่งผ่านแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

2.1.1.2 นำเบอร์เร็นต์การส่งผ่านแสงไปเขียนกราฟ โดยให้แกน x เป็นแกนของความยาวคลื่น และแกน y เป็นแกนของเบอร์เร็นต์การส่งผ่านแสง

2.1.1.3 สร้างของครอบสเปกตรัมการส่งผ่านแสงโดยการลากเส้นผ่านค่าสูงสุด (T_M) และค่าต่ำสุด (T_m) ของสเปกตรัมการส่งผ่านแสงตลอดช่วงความยาวคลื่นที่สนใจดังภาพที่ 3-10

2.1.1.4 ลากเส้นตรงตั้งฉากกับแกน x ที่ความยาวคลื่นที่สนใจให้ตัดกับของที่สร้างขึ้น ดังภาพที่ 3-11

2.1.1.5 นำค่า T_M และ T_m ที่ได้ไปแทนในสมการ 3-1

$$N = 2s \frac{T_M - T_m}{T_M T_m} + \frac{s^2 + 1}{2} \quad (3-1)$$

$$\text{เมื่อ } s = \frac{1}{T_s} + \sqrt{\frac{1}{T_s^2} - 1} \quad (3-2)$$

เมื่อ s คือ ดัชนีหักเหของกระจกสไลด์ และ T_s เป็นเบอร์เร็นต์การส่งผ่านแสงของกระจกสไลด์

2.1.1.6 นำค่า N ที่ได้จากสมการ 3-1 ไปแทนในสมการ 3-3 จะได้ดัชนีหักเห (n) ของแต่ละความยาวคลื่นในช่วงที่สนใจ

$$n = \sqrt{N + \sqrt{N^2 - s^2}} \quad (3-3)$$

2.1.2 การหาสัมประสิทธิ์การดับสูญ (k)

2.1.2.1 สัมประสิทธิ์การดูดกลืน ($\alpha_{(λ)}$) คำนวณได้จากสมการที่ 3-4

โดย d เป็นความหนาของฟิล์ม

$$\alpha_{(λ)} = -\frac{1}{d} \ln x \quad (3-4)$$

เมื่อ

$$x = \frac{F - \sqrt{F^2 - (n^2 - 1)^3(n^2 - s^4)}}{(n-1)^3(n-s^4)} \quad (3-5)$$

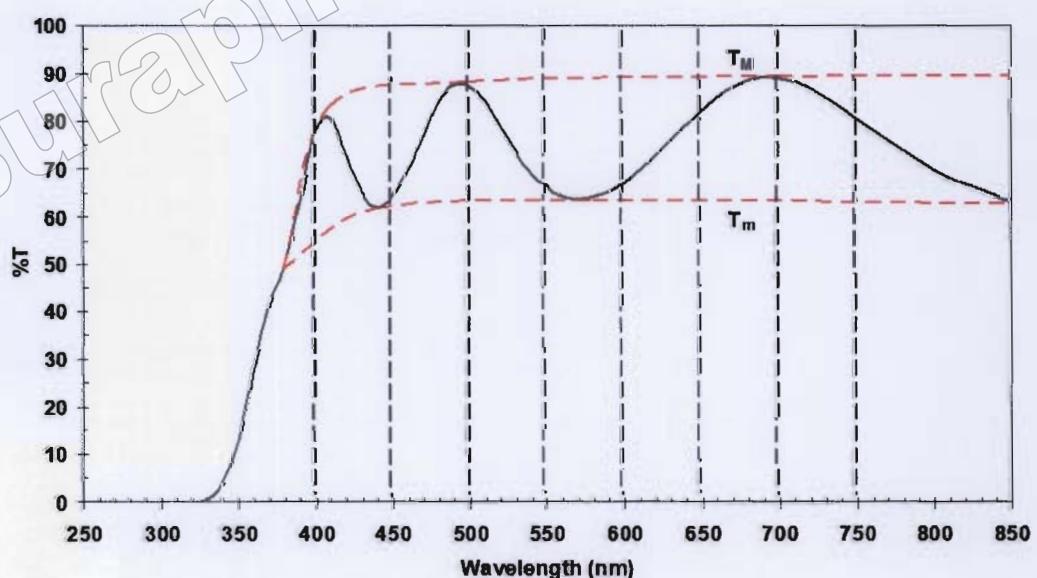
$$F = \frac{8n^2s}{T_i} \quad (3-6)$$

และ

$$T_i = \frac{2T_M T_m}{T_M + T_m} \quad (3-7)$$

2.1.2.2 แทนค่า α จากสมการที่ 3-4 ในสมการที่ 3-8 จะได้สัมประสิทธิ์การดับสูญ (k) ของแต่ละความยาวคลื่นในช่วงที่สนใจ

$$k = \frac{\alpha \lambda}{4\pi} \quad (3-8)$$



ภาพที่ 3-11 ด้วอย่างซอง (Envelope) และการเลือกค่าการส่งผ่านแสงสำหรับใช้ในการคำนวณหาดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดับสูญ

2.2 การหาค่าเอนพลังงาน (E_g)

ค่าเอนพลังงานของฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์เจือในโตรเจน ในงานวิจัยนี้ สามารถคำนวณจากสมการที่ 3-9

$$\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^m \quad (3-9)$$

เมื่อ α คือ สัมประสิทธิ์การดูดกลืน

$h\nu$ คือ พลังงานแสง

A คือ ค่าคงที่

E_g คือ ช่องว่างพลังงาน

m คือ ค่าคงที่โดยมีค่าขึ้นกับ Transition Mode ของสารกึ่งตัวนำ โดยที่

$m = 1/2$: Direct Allowed Transition

$m = 2$: Indirect Allowed Transition

โดยค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน (α) หาได้จากสมการที่ 3-10

$$\alpha = -\frac{\ln T}{d} \quad (3-10)$$

เมื่อ T คือ การส่งผ่านแสง

d คือ ความหนาของฟิล์ม

ทั้งนี้ Chiu et al. (2007) ได้อธิบายว่าฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์เป็นสารกึ่งตัวนำแบบ Indirect Allowed Transition และค่าเอนพลังงาน (E_g) มีค่าเท่ากับจุดตัดบนแกน x ของกราฟระหว่าง $(\alpha h\nu)^{1/2}$ กับ $h\nu$

แนวทางการทดลอง

งานวิจัยนี้ แบ่งการทดลองเป็น 3 ส่วนดังนี้

การทดลองที่ 1 การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียม ไดออกไซด์เฟสโโนเทส

วัตถุประสงค์ เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียม ไดออกไซด์เฟสโโนเทส แบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อยดังนี้

การทดลองที่ 1.1 การศึกษาผลของอัตราไหლแก๊สออกซิเจน

วัตถุประสงค์ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียม ไดออกไซด์เฟสโโนเทส

วิธีการทดลอง

1. การเคลือบฟิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียม ไดออกไซด์บนกระจกสไลด์ และแผ่นซิลิโคน โดยการแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจนในการเคลือบ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียม ไดออกไซด์ โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สอาร์กอนคงที่เท่ากับ 5 sccm และแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 5 sccm, 10 sccm และ 15 sccm ตามลำดับ ควบคุมความดันรวมขณะเคลือบให้คงที่เท่ากับ 7×10^{-3} mbar และใช้เวลาเคลือบนาน 90 นาที (ตารางที่ 3-1)

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่ได้ โดยศึกษาโครงสร้างผิว ขนาดผิวค่าคงที่แลดูทิช ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ตารางที่ 3-1 ผ่อนไข่การเคลือบเมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจน

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	ไทเทเนียม (99.99%)
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์ และแผ่นซิลิโคน
ความดันพื้น (mbar)	5×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	7×10^{-3}
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	8
อัตราไหลแก๊สอาร์กอน (sccm)	5
อัตราไหลแก๊สออกซิเจน (sccm)	5, 10, 15
เวลาเคลือบ (min)	90

การทดลองที่ 1.2 การศึกษาผลของความดันรวม
วัตถุประสงค์ เพื่อหาความดันรวมที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียม
โดยอกไซด์เฟสонаเกส

วิธีการทดลอง

1. การเคลือบฟิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอกไซด์บนกระ杰กสไลด์และแผ่นซิลิกอน โดยการแปรค่าความดันรวมในการเคลือบ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอกไซด์ โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สรากอนต่อแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ $5 : 15 \text{ sccm}$ แปรค่าความดันรวมควบคุมความดันรวมเท่ากับ $3 \times 10^{-3} \text{ mbar}$, $5 \times 10^{-3} \text{ mbar}$, $7 \times 10^{-3} \text{ mbar}$ และ $9 \times 10^{-3} \text{ mbar}$ ตามลำดับ และใช้เวลาเคลือบนาน 90 นาที (ตารางที่ 3-2)

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่ได้ โดยศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึกค่าคงที่แลดูพิช ความหนา และลักษณะผิว

ตารางที่ 3-2 เมื่อนำไปการเคลือบเมื่อแปรค่าความดันรวม

เงื่อนไข	รายละเอียด
เปล่าสารเคลือบ	ไทเทเนียม (99.99%)
วัสดุรองรับ	กระ杰กสไลด์ และแผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	5×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	3×10^{-3} , 5×10^{-3} , 7×10^{-3} , 9×10^{-3}
ระยะระหว่างเปล่าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	8
อัตราไหลแก๊สรากอน (sccm)	5
อัตราไหลแก๊สออกซิเจน (sccm)	15
เวลาเคลือบ (min)	90

การทดลองที่ 2 การเตรียมพิล์มบาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์เจือในไตรเจน
วัตถุประสงค์ เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเคลือบพิล์มบาง ไทเทเนียม
ไดออกไซด์เจือในไตรเจน มีการทดลองดังนี้

การทดลองที่ 2.1 การศึกษาผลของอัตราไหლแก๊สในไตรเจน

วัตถุประสงค์ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สในไตรเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบพิล์มบาง
ไทเทเนียม ไดออกไซด์เจือ ในไตรเจน

วิธีการทดลอง

1. การเคลือบพิล์ม ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบพิล์มบาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์เจือ
ในไตรเจนบนกระ杰สไอล์ดและแผ่นซิลิกอน โดยการแบร์ค่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจนในการเคลือบ
เพื่อหาอัตราไหลแก๊สในไตรเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบพิล์มบาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์เจือ
ในไตรเจน โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สสารก่อนต่อแก๊สออกซิเจนคงที่เท่ากับ 5 : 15 sccm
แบร์ค่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 0 sccm, 1 sccm, 2 sccm และ 3 sccm ตามลำดับ
ควบคุมความดันรวมให้คงที่เท่ากับ 7×10^{-3} mbar และใช้เวลาเคลือบนาน 90 นาที (ตารางที่ 3-3)

2. ระหวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพิล์มที่ได้ โดยศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึก
ค่าคงที่แอลติทิช ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ตารางที่ 3-3 เชื่อมโยงการเคลือบเมื่อแบร์ค่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจน

เงื่อนไข	รายละเอียด
เปล่าสารเคลือบ	ไทเทเนียม (99.99%)
วัสดุรองรับ	กระ杰สไอล์ด และแผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	5×10^{-3}
ความดันรวม (mbar)	7×10^{-3}
ระยะระหว่างเปล่าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	8
อัตราไหลแก๊สสารก่อน (sccm)	5
อัตราไหลแก๊สออกซิเจน (sccm)	15
อัตราไหลแก๊สในไตรเจน (sccm)	0, 1, 2, 3
เวลาเคลือบ (min)	90

การทดลองที่ 3 การศึกษาสมบัติทางแสงของฟลัมบาง ไทด์เนียม ไดออกไซด์เจือในไตรเจน

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราไฟลแก๊สในไตรเจนต่อสมบัติทางแสงของฟลัมบาง ไทด์เนียม ไดออกไซด์เจือในไตรเจน

การศึกษาสมบัติทางแสง และแบบพลังงานของฟลัมบาง ไทด์เนียม ไดออกไซด์เจือ ในไตรเจน โดยนำฟลัมบาง ไทด์เนียม ไดออกไซด์เจือในไตรเจนที่เคลื่อนบนกระชากไอล์ด จากการทดลองที่ 2 ไปวัดค่าการส่งผ่านแสงด้วยเครื่องสเปกโตร โฟโตมิเตอร์ แล้วนำมาคำนวณหา ดัชนีหักเห และสัมประสิทธิ์การดับสูญ ด้วยวิธี Envelope ส่วนแบบพลังงานคำนวณจากสเปกตรัม การส่งผ่านแสง จากสมการ $\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^m$ เมื่อ $m = 2$ (Indirect Allowed Transition) (Chiu et al., 2007) โดยค่าแบบพลังงาน (E_g) มีค่าเท่ากันจุดตัด眷น แกน x ของกราฟระหว่าง $(\alpha h\nu)^{1/2}$ กับ $h\nu$